

### 关键指标

频率: 32~37GHz  
增益: 28dB  
1dB 压缩点输出功率: 9dBm  
工作电压: +5V  
工作电流: 20mA  
芯片尺寸: 2.27mm×0.9mm×0.1mm

### 产品简介

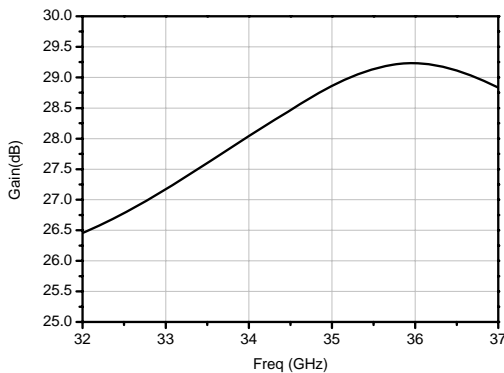
HG118FD 是一款 32~37GHz 低噪声放大器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 增益为 28dB, 1dB 压缩点输出功率为 9dBm。

### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+5V)

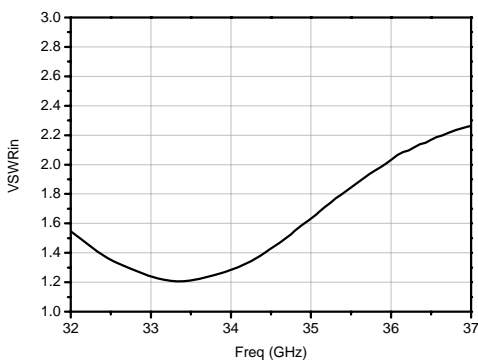
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	32~37		
增益(dB)	—	28	—
增益平坦度(dB)	—	正斜率	—
输入驻波	—	2	—
输出驻波	—	1.5	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	9	—

### 典型测试曲线

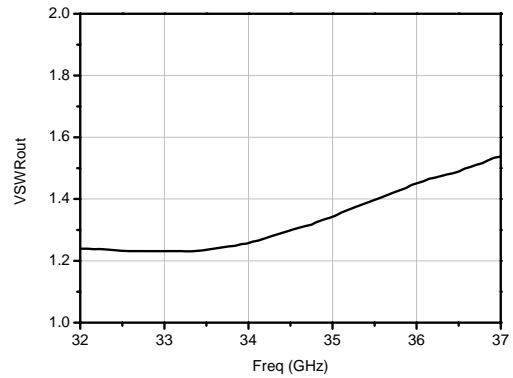
增益



输入驻波



输出驻波

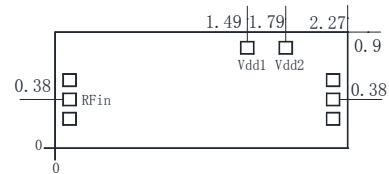


Freq(GHz)	32	35	37
P-1(dBm)	6.7	9.5	9.3

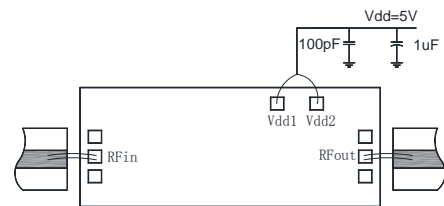
### 绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

### 外形和端口尺寸 (mm)



### 推荐装配图



### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400μm;
5. 芯片微波端有隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。